26. スイッチング電源の設計(2)

26. Design of the Switch-Mode Power Supply (SMPS) (2)

講義内容

- 1. 電源用インダクタ
- 2. 磁気回路と電磁気学
- 3. 巻数Nの導出
- 4. エアギャップのメリットとデメリット

DC-DCコンバータの設計

1 安定動作 すること

出力 リプル (脈動) 電圧が 小さいこと (低 リプルノイズ)

2 高 効率(=低 損失)

4

負荷過渡 応答特性が良い (**負荷変動** に強い)

①:回路設計 (パワーステージ・制御 回路·保護 回路·スナバ 回路)

②:素子・冷却体(ヒートシンク)選定・動作/スイッチングモード選択

③:素子選定・回路のレイアウト(配置・配線パターン)設計

④: 制御系 設計 (制御 回路 (アナログ)・アルゴリズム (ディジタル))



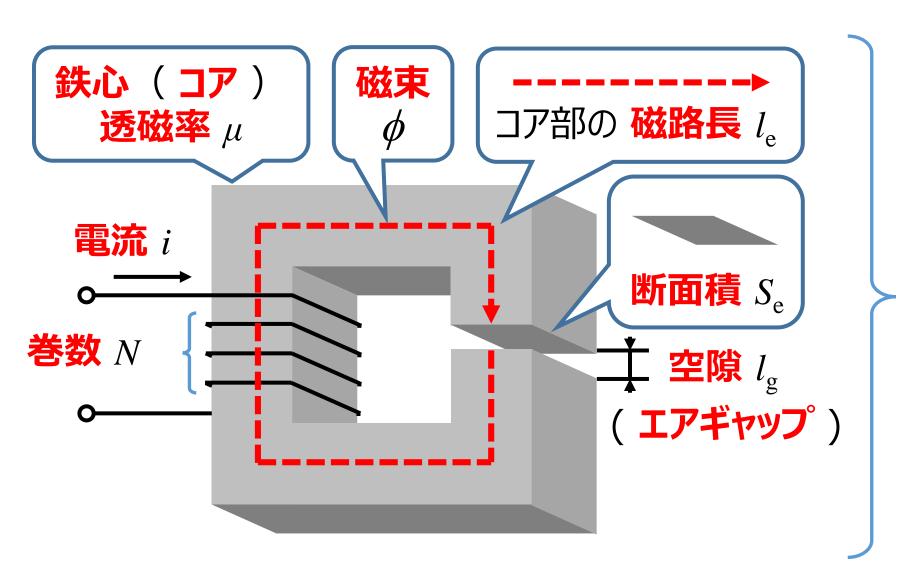
これらを考慮した上で設計 ※入力の急激な変動は無いものとする

電源の設計の手順の一例

- 1. 回路の動作条件の設定(入力電圧,出力電力,負荷の種類等)
- 2. 回路の要求の比重選択(高効率 vs 小型化 vs コスト vs etc...)
- 3. 回路動作の種類の選択 (連続導通モード,不連続導通モード等)
- 4. パワーステージの設計
 - インダクタ の設計
 - 冷却体(ヒートシンク)の設計
 - ▶ 半導体デバイスの選定及び ゲート駆動回路周りの設計
 - ▶ キャパシタの選定
- 5. コントロールステージ (制御部) の設計
- 6. 保護回路及びフィルタの設計
- 7. 回路のレイアウトの構成(配置・配線パターン)

今回はインダクタの設計に ついて講義を行う (あくまで講義レベル)

空隙のある電源用インダクタ



インダクタは **磁気回路** を用いて **等価回路** 表現する

※トランスも同様

電気回路と磁気回路

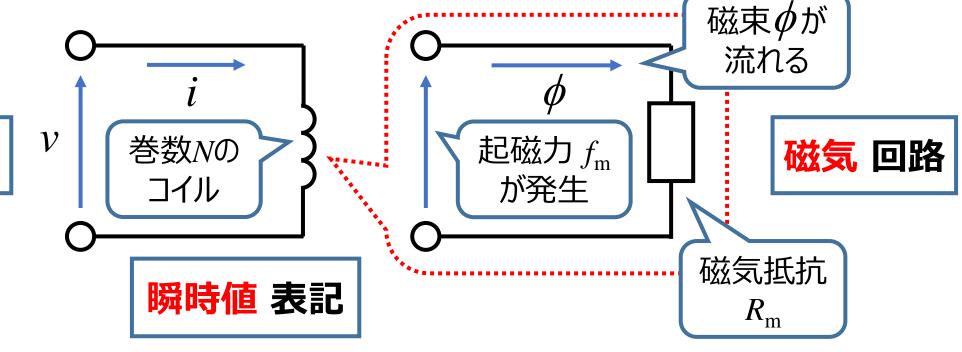


構成要素

- 磁気回路を構成する 鉄心 (コア)
 - ・ 鉄心に巻かれた複数の **コイル**



インダクタで 復習



電気 回路

自己インダクタンスL

$$f_{\rm m} = Ni$$

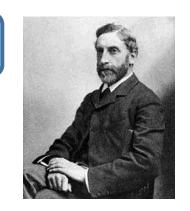
$$f_{\rm m} = R_{\rm m} \phi$$

$$\varphi = N\phi$$

磁束 ϕ

磁束鎖交数 φ

$$f_{\rm m} = Ni = R_{\rm m} \phi = R_{\rm m} \frac{\varphi}{N} = R_{\rm m} \frac{Li}{N}$$



)

 $f_{\rm m}=R_{\rm m}\phi:$ ホプキンソン の法則 (磁気回路における オーム の法則)

John Hopkinson (1849~1898)

自己インダクタンスL:

磁束鎖交数 φ と電流 i の **比例係数**

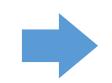


$$\varphi = Li$$

自己インダクタンスの式になるように式を変形

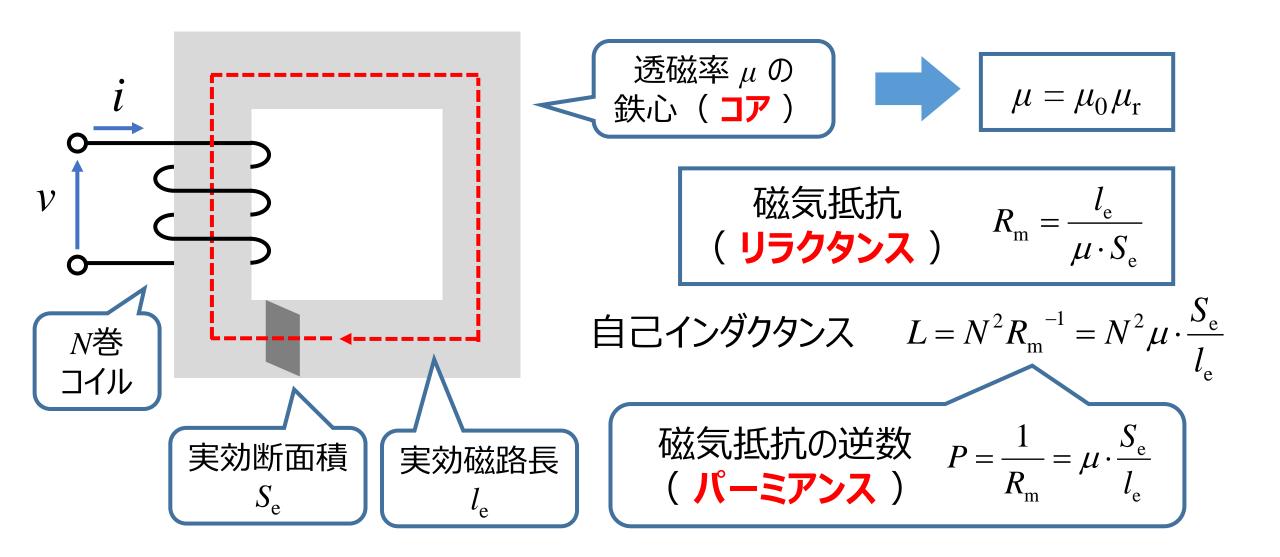


$$L = N^2 R_m^{-1}$$

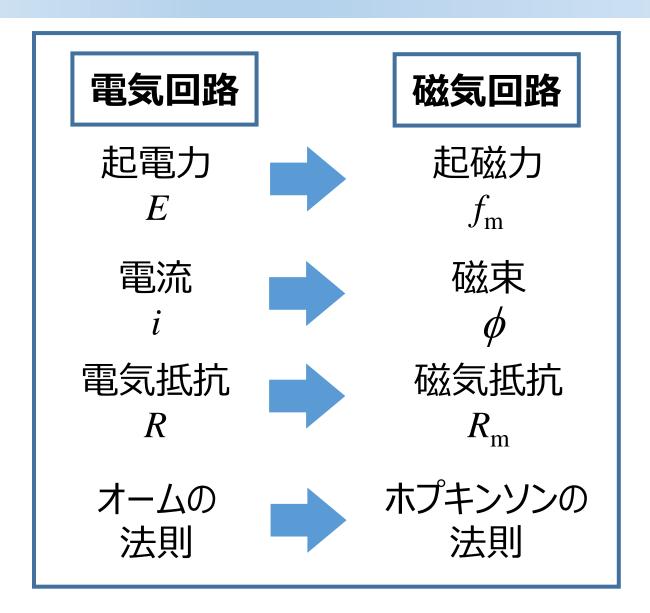


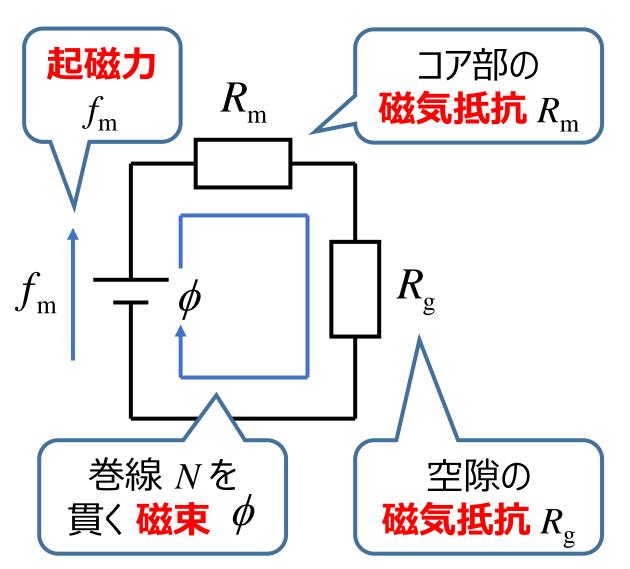
磁気抵抗は?

自己インダクタンス Lと磁気抵抗 R_m (コイル)



磁気回路表現(電気回路と磁気回路の対応)



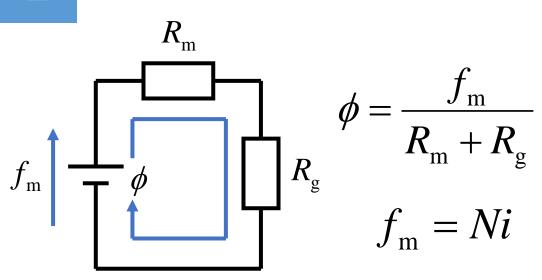


巻数Nの導出

1

$$\left. egin{aligned} arphi & N\phi \ arphi & = Li \end{aligned}
ight.$$
 $L = rac{N\phi}{i}$

2 ホプキンソンの法則



3

磁気抵抗値 (空隙あり)

$$R_{\rm m} = \frac{l_{\rm e}}{\mu \cdot S_{\rm o}} = \frac{l_{\rm e}}{\mu_{\rm o} \cdot \mu_{\rm r} \cdot S_{\rm o}} \qquad \mu = \mu_{\rm o} \mu_{\rm r}$$

$$R_{\rm g} = \frac{l_{\rm g}}{\mu_0 \cdot S_{\rm e}}$$
 空気中の 比透磁率 は $\mu_{\rm r} = 1$ であるため

$$R_{\rm m} = \frac{l}{\sigma \cdot S} = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

巻数Nの導出

1

2

3

より,

$$L = \frac{N\phi}{i} = \frac{N}{i} \cdot \frac{f_{\rm m}}{R_{\rm m} + R_{\rm g}} = N^2 \cdot \frac{1}{\frac{l_{\rm e}}{\mu_0 \cdot \mu_{\rm r} \cdot S_{\rm e}} + \frac{l_{\rm g}}{\mu_0 \cdot S_{\rm e}}}$$

インダクタンス係数

(AL-Value)

$$\frac{L}{N^2} = \frac{1}{R_{\rm m}}$$
$$= \mathcal{N} - \exists \mathcal{P} > \mathcal{X}$$

よって,
$$N = \sqrt{L \left(\frac{l_e}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot S_e} + \frac{l_g}{\mu_0 \cdot S_e} \right)} = \sqrt{\frac{L}{\mu_0 \cdot S_e} \left(\frac{l_e}{\mu_r} + l_g \right)}$$

磁気回路からインダクタの巻数を導出することが出来た! (※あくまで 近似)

計算例

汎用フェライトコア: PC40EC90×90×30 (TDK社)

	形状パラメータ						電気的特性
品番	コア定数 C ₁ (mm ⁻¹)	C2×10 ⁻² (mm ⁻³)	実効 断面積 Ae (mm²)	実効 磁路長 ℓ e (mm)	実効体積 Ve (mm³)	質量(約) (g)	AL-value (nH/N²) 1kHz 0.4A/m 23°C
PE22 EC70×69×16 PC40 EC70×69×16 PE90 EC70×69×16	0.5138891	0.18322	280	144	40420	250 250 255	3910±25% 4845±25% 4634±25%
PE22 EC90×90×30 PC40 EC90×90×30 PE90 EC90×90×30	0.3533380	0.05648	626	221	138270	635 635 648	5925±25% 7415±25% 7093±25%
PE22 EC120×101×30 PC40 EC120×101×30 PE90 EC120×101×30	0.3300745	0.04278	772	255	196490	986 986 1007	6395±25% 8025±25% 7676±25%



http://ja.hz-careful-tr.com/ transformer-core/ec-ferritecore.html

実効断面積: $S_{\rm e}(A_{\rm e}) = 626 [{\rm mm}^2]$

実効磁路長: $l_e = 221[mm]$

使用するコアの 比 透磁率: 2300

PC40: フェライトの材料

EC:フェライトコアの形状

※EE, EI, EER等

計算例

インダクタンスを L=116[μ H] , エアギャップを $l_{\rm g}$ = 2[\min] とすると,

$$N = \sqrt{\frac{L}{\mu_0 \cdot S_e} \left(\frac{l_e}{\mu_r} + l_g\right)} = \sqrt{\frac{116 \times 10^{-6}}{4\pi \times 10^{-7} \times 626 \times 10^{-6}} \left(\frac{221 \times 10^{-3}}{2300} + 2 \times 10^{-3}\right)}$$

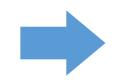
= 17.58[Turn]



真空中 の透磁率

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [H/m]$$

巻数は実数で表す。その場合, 四捨五入をせずに整数値を一つ上昇させる



N = 18[Turn]

エアギャップの必要性

$$R_{\rm m} = \frac{l_{\rm e}}{\mu_0 \cdot \mu_{\rm r} \cdot S_{\rm e}}$$

$$R_{\rm g} = \frac{l_{\rm g}}{\mu_0 \cdot S_{\rm e}}$$

 $l_{\rm e}>>l_{\rm g}$ を考慮しても, 強磁性体の比透磁率の 影響により, $R_{\rm g}>R_{\rm m}$ となる

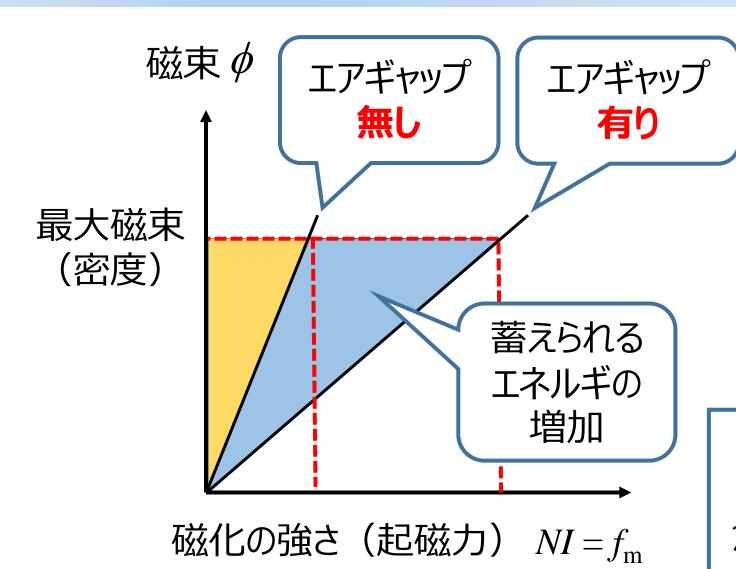
前述の計算例で 比較すると,

$$R_{\rm m} = \frac{l_{\rm e}}{\mu_{\rm 0} \cdot \mu_{\rm r} \cdot S_{\rm e}} \approx 122 \times 10^{3} \, [1/\,\text{H}]$$

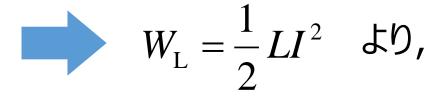
$$R_{\rm g} = \frac{l_{\rm g}}{\mu_{\rm 0} \cdot S_{\rm e}} \approx 254 \times 10^{4} \, [1/\,\text{H}]$$

磁気抵抗が 約20倍ほど 大きくなる

エアギャップの必要性



磁気抵抗の増加により, 最大磁束に到達するのに 必要な電流値が大きくなる



蓄えられるエネルギが増大!

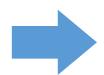
※最大磁東密度を超えると 磁気飽和 が生じて電流が 急激に増大してしまう (不安定)

エアギャップの必要性

$$W_{\rm L} = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \cdot N \cdot \phi \cdot i = \frac{1}{2} \cdot f_{\rm m} \cdot \phi = \frac{1}{2} \cdot (R_{\rm m} + R_{\rm g}) \cdot \phi^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot R_{\rm m} \cdot \phi^2 + \frac{1}{2} \cdot R_{\rm g} \cdot \phi^2$$

電気回路における 電力 *P = VI*



1½ も考慮すると **三角形** の **面積** となる!

コア部のエネルギ

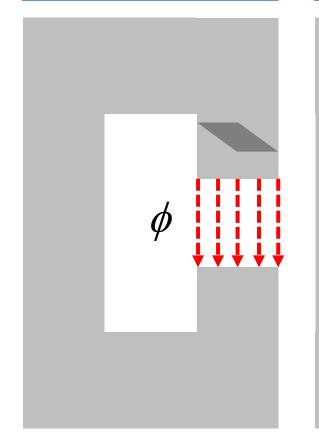
空隙部のエネルギ

磁気抵抗の大きさが、そのまま 蓄えられるエネルギの大きさに繋がる

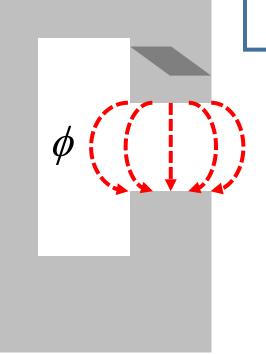
$$\mathcal{S} = \frac{R_{\rm g}}{R_{\rm m}} = \frac{\frac{l_{\rm g}}{\mu_0 \cdot S_{\rm e}}}{\frac{l_{\rm e}}{\mu_0 \cdot \mu_{\rm r} \cdot S_{\rm e}}} = \mu_{\rm r} \cdot \frac{l_{\rm g}}{l_{\rm e}}$$

フリンジング効果

理想状態



実際の状態



フリンジング効果

エアギャップでは、磁気抵抗を減らすべく 磁束の通過する断面積をコアの断面積 よりも 大きく しようとして磁束が 膨らむ

$$R_{\mathrm{g}} = rac{l_{\mathrm{g}}}{\mu_{0} \cdot S_{\mathrm{e}}}$$
 漏れ磁束 の要因となる (ノイズ にもなる)

エアギャップ中の断面積が計算と実測で差が出てしまう